

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏
幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也

日時 6月29日(水) 10:00~17:20

会場 キャンパス・イノベーションセンター東京(港区芝浦3-3-6. <http://www.cictokyo.jp/access.html>)

議題 MOSデバイス・メモリ高性能化—材料・プロセス技術

1. [依頼講演] 強誘電体 HfSiO₂ キャパシタにおける形成プロセスと膜物性・電気特性の関係
○上牟田雄一・藤井章輔・高石理一郎・井野恒洋・中崎 靖・齋藤真澄・小山正人(東芝)
2. [依頼講演] 配向制御した HfO₂ 基強誘電体薄膜の作製と特性評価
○舟窪 浩・清水荘雄・片山きりは・三村和仙(東工大)
3. [依頼講演] 強誘電体絶縁膜の負性容量を利用した急峻スイッチング実現のための SOI-FET 設計指針
○太田裕之・右田真司・服部淳一・福田浩一(産総研)・鳥海 明(東大)
4. 強誘電体ナノワイヤキャパシタの作製—強誘電体メモリへの応用を目指して—
○藤沢浩訓・清水 勝・中嶋誠二(兵庫県立大)
5. 多段積層型トランジスタ構造を用いた Fe-FET NAND 論理の提案とそのロジック LSI への適用検討
○渡辺重佳(湘南工科大)・横田智広(DNP データテクノ)
6. ZrO₂/Al₂O₃/ZrO₂ 多層を用いた DRAM キャパシタにおける Al₂O₃ 層が電気特性に及ぼす効果
○女屋 崇(明大/物質・材料研究機構)・生田目俊秀・澤田朋実(物質・材料研究機構/JST)・栗島一徳(明大/物質・材料研究機構)・澤本直美(明大)・大井暁彦・知京豊裕(物質・材料研究機構)・小椋厚志(明大)

午後(13:30~)

7. SiO₂ の絶縁破壊と局所陽極酸化を用いた抵抗変化デバイス
○角嶋邦之・若林 整・筒井一生・岩井 洋(東工大)
8. Ge 基板上エピタキシャル GeSn 膜の電気的活性な欠陥の評価
○金田裕一・兼松正行・坂下満男・竹内和歌奈・中塚 理・財満鎮明(名大)
9. XPS による SiO₂/半導体界面の電位変化及びダイポールの定量
○藤村信幸・大田晃生・渡辺浩成・牧原克典・宮崎誠一(名大)
10. リモート酸素プラズマ支援 CVD による低温 SiO₂ 薄膜形成
○ゲンズァン チュン・藤村信幸・竹内大智・大田晃生・牧原克典・池田弥央・宮崎誠一(名大)
11. タンタル酸ナノシート/SiO₂/Si 界面バンドオフセットにおける UV 照射の効果
○速水脩平・豊田智史・福田勝利(京大)・菅谷英生(パナソニック)・森田将史・中田明良・内本喜晴・松原英一郎(京大)
12. [依頼講演] カルコゲナイド系層状物質の電界効果トランジスタ素子への応用 上野啓司(埼玉大)
13. [依頼講演] 2次元原子層物質の構造制御合成と光電子デバイス応用 ○加藤俊顕・金子俊郎(東北大)
14. [依頼講演] 自己組織化単分子膜をゲート絶縁膜に用いた低電圧駆動 MoS₂ FET の作製
○川那子高暢・小田俊理(東工大)
15. TFT 応用に向けた RF マグネトロンスパッタリング法による MoS₂ 膜の形成
○大橋 匠・松浦賢太郎(東工大)・石原聖也・日比野祐介・澤本直美(明大)・角嶋邦之・筒井一生(東工大)・小椋厚志(明大)・若林 整(東工大)
16. [依頼講演] 遷移金属ダイカルコゲナイド原子層の合成と評価 宮田耕充(首都大東京)

◆応用物理学会;シリコンテクノロジー分科会共催

◎[依頼講演]はシリコンテクノロジー分科会で企画された講演です。

◎研究会終了後、懇親会を予定していますので御参加下さい。

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

8月1日(月)~3日(水) 中央電気倶楽部 [6月3日(金)] テーマ:アナログ, アナデジ混載, RF 及びセンサインタフェース回路, 低電圧/低消費電力技術, 新デバイス・回路とその応用

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp